

Centro Interuniversitario di Struttura della Materia - MPI
Gruppo Nazionale di Struttura della Materia - CNR
SETTORE SEMICONDUTTORI

CONVEGNO SCIENTIFICO ANNUALE

Pavia, 15-17 febbraio 1988

COMITATO ORGANIZZATORE

A. Baldereschi	Università di Trieste, <i>Coordinatore</i>
S. Baroni	Università di Trieste, <i>Segretario</i>
A. Borghesi	Università di Pavia
U. Campisano	Università di Catania
C. Canali	Università di Padova
M. Capizzi	Università La Sapienza, Roma
G. Gasparrini	Elettronica S.p.A., Roma
C. Ghezzi	Università di Parma
G. Mula	Università di Cagliari
L. Reggiani	Università di Modena
L. Vasanelli	Università di Bari

COMITATO DI PROGRAMMA

A. Baldereschi <i>Epitassie avanzate e dispositivi</i>	Università di Trieste
C. Canali <i>Progetti nazionali ed europei</i>	Università di Padova
S. Cova <i>Epitassie avanzate e dispositivi</i>	Politecnico di Milano
F. Evangelisti <i>Semiconduttori amorfi</i>	Università La Sapienza, Roma
G. Ottaviani <i>Superfici ed interfacce</i>	Università di Modena
C. Paorici <i>Semiconduttori "bulk"</i>	Università di Parma
E. Rimini <i>Progetti nazionale ed europei</i>	Università di Catania

- Il convegno si terrà presso l'Università degli Studi di Pavia, Palazzo Centrale, Aula Foscoliana, Strada Nuova 65.
- Non è previsto un servizio di prenotazione alberghiera. Gli interessati dovranno dunque provvedere personalmente.

Mercoledì 17 Febbraio 1988

Epitassie avanzate e dispositivi - II

Coordinatori: A. Baldereschi (Università di Trieste) e S. Cova (Politecnico di Milano)

- 9.00 C. GHEZZI, A. PARISINI, L. TARRICONE, J.L. STAELI e D. MARTIN (Università di Parma e Politecnico di Losanna, Svizzera): *Caratterizzazione di buche quantiche GaAs/GaAlAs mediante misure ottiche e di fototrasporto.*
- 9.30 A. CHIARI, M. COLOCCI, F. FERMI, R. QUERZOLI, A. VINATTIERI e L. ANGELONI (Università di Firenze e Università di Parma): *Fotoluminescenza risolta in tempo di strutture a buche quantiche GaAs/GaAlAs.*
- 10.00 S. BARONI e R. RESTA (Università di Trieste e SISSA, Trieste): *Discontinuità di banda in eterostrutture GaAs/AlAs.*
- 10.30 E. GOMBIA, A. BOSACCHI, M. CAPIZZI, C. COLUZZA, C. GHEZZI, R. MOSCA e L. VANZETTI (MASPEC-CNR, Parma; Università La Sapienza, Roma; Università di Parma): *Effetti di idrogenazione su livelli profondi e shallow in strati epitassiali di GaAs ottenuti per MBE.*
- 11.00 INTERVALLO
- 11.15 H. VON KÄNEL (Laboratorium für Festkörperphysik, ETH, Zurigo, Svizzera): *Heterojunctions and superlattices grown by Si-MBE.*
- 12.00 A. LACAITA, G. RIPAMONTI e S. COVA (CEQSE-CNR, Politecnico di Milano): *Dispositivi a valanga in Si per misure di transistori da livelli profondi con risoluzione al nanosecondo.*
- 12.30 S. BERNARDI (CSELT, Torino): *Crescita LPE di HgCdTe su CdTe.*

Superfici ed interfacce

Coordinatore: G. Ottaviani (Università di Modena)

- 15.00 S. NANNARONE (Università La Sapienza, Roma): *Superficie di semiconduttori e tecniche di analisi.*
- 15.45 S. OSSICINI (Università di Modena) *Proprietà elettroniche di materiali semiconduttori in contatto con metalli.*
- 16.15 INTERVALLO
- 16.30 A. RIZZI *Analisi mediante EELS di superfici di Si coperte da metalli.*
- 17.00 G. QUEIROLO (SGS-Thomson Microelettronica, Agrate) *Interfaccia ossido/polisilicio.*
- 17.30 S. SELCI (Università Tor Vergata, Roma): *Studio di superfici di semiconduttori con microscopia ad effetto tunnel.*